

05

Магнитооптические и магниторезистивные свойства спин-клапанных структур на основе Со, Си и Au

© И.В. Чешко, С.И. Проценко, Л.В. Однодворец, Р. Shifalovich

Сумський національний університет, Суми, Україна

E-mail: protsenko@aph.sumdu.edu.ua

Поступило в Редакцию 23 апреля 2009 г.

Предложена методика формирования функционального элемента спин-клапанной структуры путем послойной конденсации наноразмерных Со, Си, Au и Cr с определенной последовательностью температурной обработки в процессе конденсации. Исследованы магниторезистивные и магнитооптические свойства и установлена их корреляция со структурно-фазовым состоянием полученных структур и их составляющих.

PACS: 75.47.De, 73.21.Ac, 61.16.Bg

Материалы со спин-зависимым рассеиванием электронов на основе Со и Си или Au в виде мультислоев, пленочных гранулированных сплавов и спин-клапанных структур широко применяются в современном микроприборостроении и сенсорной технике [1]. Особенno перспективным является использование таких материалов при создании накопителей большой емкости. Относительная простота изготовления таких структур и широкий спектр возможностей их применения объясняет заинтересованность в экспериментальном и теоретическом исследовании физических процессов в данных пленочных структурах. Однако методики изготовления спин-клапанных структур ряда авторов (см. например, [2,3]) базируются лишь на результатах исследований их магнитотранспортных свойств, а вопросу изучения особенностей структурно-фазового состояния и диффузионных процессов в них и их связи с магниторезистивными свойствами удалено достаточно мало внимания.

По результатам исследования особенностей структурного и фазового состояния двухслойных пленочных систем на основе материалов со спин-зависящим рассеиванием электронов на основе Cu(Au, Ag)

и Со [4] нами была выбрана конфигурация функционального элемента спин-клапанной структуры в виде многослойной пленочной системы Au(3)/Co(3)/Au(Cu)(6)/Co(20)/Au(40)/Cr(3)Sub (Sub — подложка) по аналогии с работой [5].

Пленочные образцы получались методом термического испарения в условиях сверхвысокого вакуума (10^{-8} Pa). В качестве подложек использовались монокристаллы Si(001). Рабочие магнитные слои Со, которые разделены немагнитной прослойкой из Cu или Au толщиной 6 nm, отличаются по толщине: толщина верхнего „мягкого“ слоя составляет приблизительно 15% от толщины нижнего „жесткого“ слоя (3 и 20 nm соответственно). Такое сочетание обеспечивает функционирование в магнитном поле всего спин-клапана в соответствии со схемой, представленной на рис. 1. Верхний слой Со более чувствительный к изменению величины магнитного поля, и процесс перемагничивания его доменной структуры начинается при меньших значениях поля, в то время как нижний слой имеет большее сопротивление к перемагничиванию. Явление гигантского магнитосопротивления (ГМС) как раз и проявляется в интервале $\Delta B = B_1 - B_2$, где B_1 и B_2 — индукция поля начала перемагничивания нижнего и верхнего слоя соответственно. Вспомогательными слоями в нашей структуре выступают нижний слой Cr, который имеет большую адгезию и не смешивается со слоем Au (40 nm), выполняющим функции нижнего электрического контакта. Верхний тонкий слой Au (3 nm) также исполняет роль электроконтакта и функцию защитного слоя всей структуры. Выбор промежуточного слоя был осуществлен с учетом того, что в системах с фрагментами Cu/Со или Au/Со наблюдаются наивысшие значения ГМС. Согласно предложенной нами схеме, разница в коэрцитивности нижнего „жесткого“ и верхнего „мягкого“ слоев Со обеспечивается разницей в толщинах. Усилить разницу в магнитных характеристиках слоев можно с помощью дополнительной термообработки. Нами было предложено получать слои Со при разных температурах подложки. Нижний, более толстый слой, получался при температуре подложки 950 K, а верхний — при комнатной. Основой для этого послужили исследования магнитооптического эффекта Керра (МОКЕ) в однослойных пленках Со, полученных при разных температурах подложек. Так, коэрцитивность пленки, полученной при высокой температуре подложки, приблизительно в 5–6 раз больше, чем у пленки, полученной при комнатной температуре.

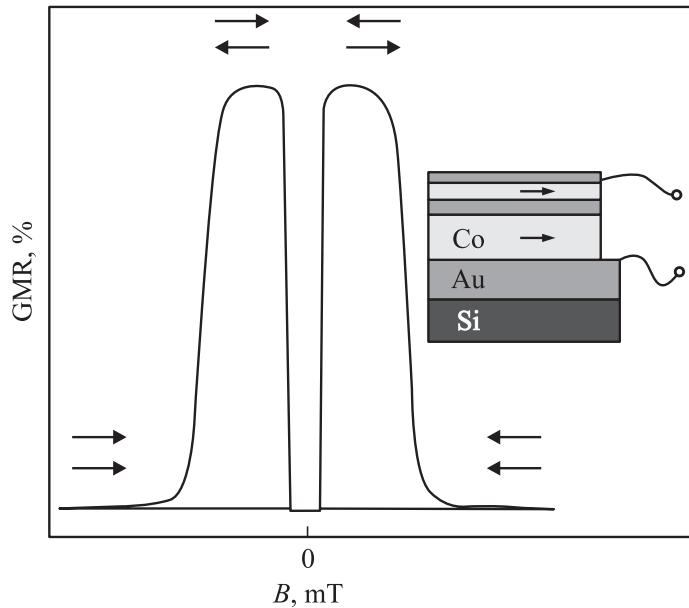


Рис. 1. Устройство спин-клапана Au(3)/Co(3)/Au(Cu)(6)/Co(20)/Au(40)/Cr(3)/Sub и схема его функционирования в магнитном поле. Стрелками указаны направления векторов намагниченности в верхнем и нижнем магнитных слоях.

Были детально изучены магнитные характеристики однослойных необработанных и отожженных при разных температурах однослойных пленок Со, которые имеют анизотропию коэрцитивности. Максимальная анизотропия наблюдается при начальных низких температурах отжига $T_{an} = 350–500$ К. Это можно объяснить особенностями изменения кристаллической структуры однослойных пленок Со. На начальной стадии при низких температурах в пленках Со начинается процесс залечивания дефектов, что приводит к улучшению доменной структуры пленки, которое выражается в увеличении магнитной анизотропии образца. Существенные изменения в структуре можно наблюдать при температурах $T_{an} \geqslant 600$ К, когда происходит переход к ГЦК фазе, что сопровождается резким увеличением среднего размера кристаллитов, коэрцитивности и потерей выраженной магнитной анизотропии.

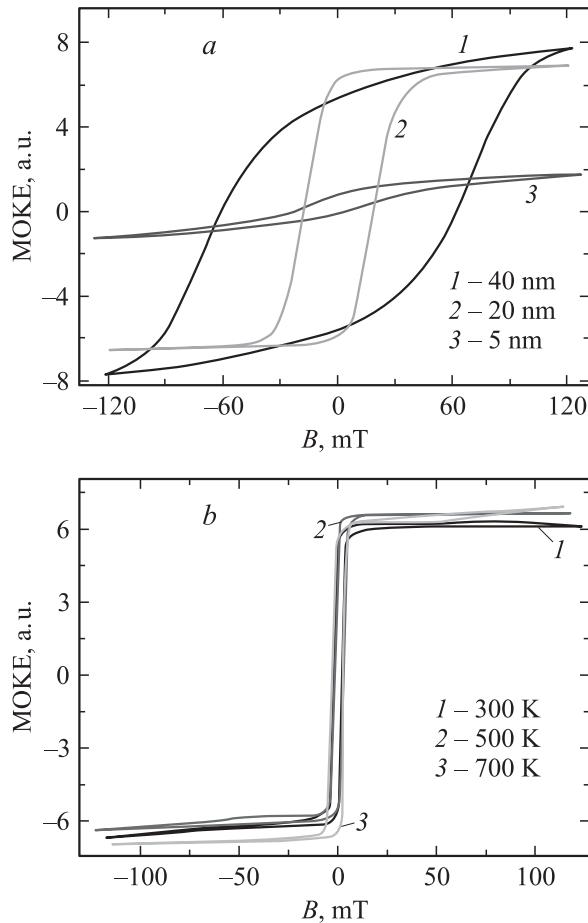


Рис. 2. МОКЕ для систем: *a* — $\text{Au}(15)/\text{Co}/\text{Sub}$ с разной толщиной слоя Со после отжига при $T_{an} = 700 \text{ K}$; *b* — $\text{Au}(5)/\text{Co}(3)/\text{Cu}(6)/\text{Co}(20)/\text{Au}(40)/\text{Cr}(3)/\text{Sub}$ при разных температурах отжига; *c* — $\text{Au}(5)/\text{Co}(3)/\text{Au}(6)/\text{Co}(20)/\text{Au}(40)/\text{Cr}(3)/\text{Sub}$ при разных температурах отжига; *d* — $\text{Au}(5)/\text{Co}(3)/\text{Cu}(6)/\text{Co}(20)/\text{Au}(40)/\text{Cr}(3)/\text{Sub}$ при разных температурах отжига (нижний слой Со получен при температуре подложки $T_{Sub} = 950 \text{ K}$).

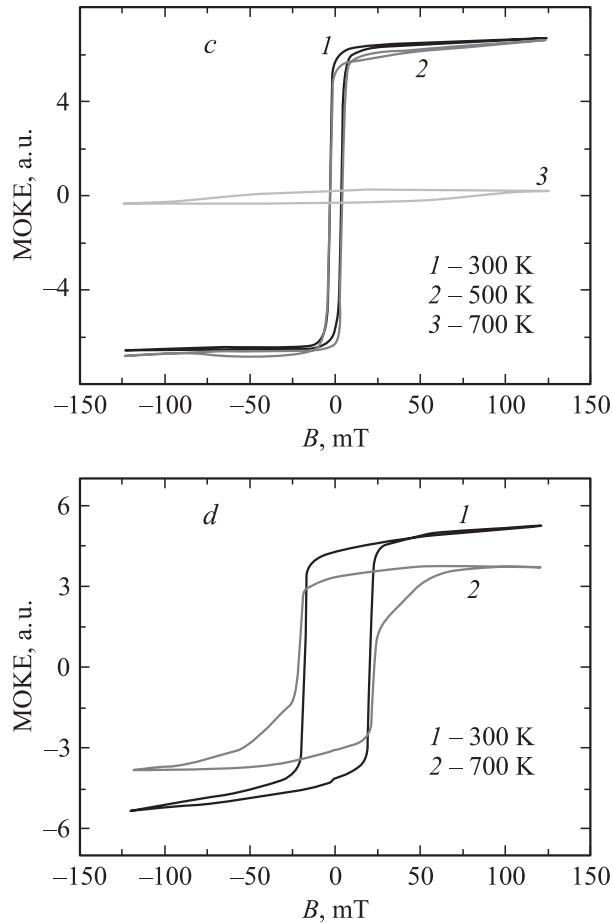


Рис. 2 (продолжение).

При переходе к двухслойным системам Cu/Сo или Au/Сo изменяется внешний вид сигнала MOKE, который подтверждает вывод ряда работ, и в частности [3,4], об образовании твердых растворов (ТР) (Cu, Co) и (Au, Co). Так, для систем Au/Co с разной концентрацией атомов Co после термообработки при $T_{an} = 700$ K во всех случаях имеет место

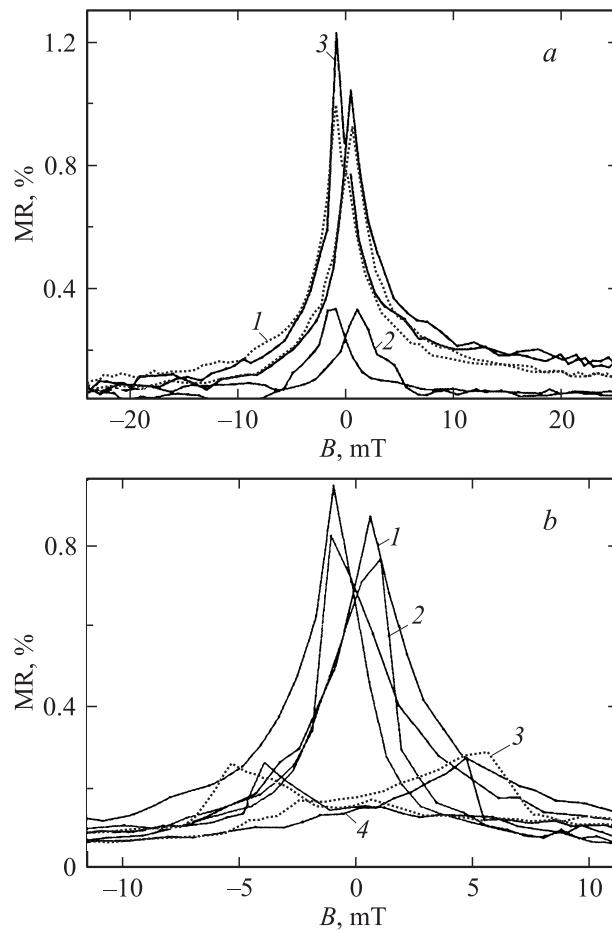


Рис. 3. MR функциональных элементов спин-клапанных структур: *a* — Au(5)/Co(3)/Cu(6)/Co(20)/Au(40)/Cr(3)/Sub при разных температурах отжига (*1* — $T_n = 300$ K, $T_{om} = 300$ K; *2* — $T_n = 300$ K, $T_{om} = 700$ K; *3* — $T_n = 950$ K, $T_{om} = 300$ K); *b* — Au(5)/Co(3)/Cu(*x*)/Co(20)/Au(40)/Cr(3)/Sub с разной толщиной прослойки *x* (*1* — 6 nm, *2* — 8 nm и *3* — 12 nm).

нормальный характер зависимости MOKE в виде петли гистерезиса, что отвечает случаю образованию гранулированного состояния Со в матрице ТР. В случае системы Cu/Сo петля гистерезиса по форме существенно не изменяется во время отжигания образцов при температурах $T_{an} < 800$ К, что связано с образованием ТР уже в процессе конденсации. На рис. 2, *a* представлено сравнение формы сигнала MOKE для отожженных при 700 К двухслойных систем Au(15)/Co(*x*)/Sub, где *x* = 5, 20 и 40 nm, что отвечает разной концентрации атомов Со.

В спин-клапанных структурах с прослойкой Cu или Au (рис. 2, *b, c*) зависимость MOKE определяется нижним „жестким“ слоем Со. Отжиг систем со слоем Cu не приводит к существенным изменениям, поскольку процесс образования ТР состоялся при конденсации. Значительные изменения зависимости MOKE от индукции магнитного поля наблюдаются при отжиге спин-клапана со слоем Au при температуре 700 К. Это, очевидно, происходит в результате образования ТР (Au, Со) по всему объему пленки. Доказательством этого может быть приведенная на рис. 2, *d* зависимость для системы Au(5)/Co(3)/Cu(6)/Co(20)/Au(40)/Cr(3)/Sub. После отжига при $T_{an} = 700$ К форма петли гистерезиса становится „ступенькоподобной“, что свидетельствует о быстродействии функционального элемента в магнитном поле, которое может обеспечить, например, его работу в диодном режиме или в режиме переключений.

На рис. 3, *a* приведена зависимость магнитосопротивления $MR = (R(H) - R(0)) \cdot 100\% / R(0)$ для функциональных элементов Au(5)/Co(3)/Cu(6)/Co(20)/Au(40)/Cr(3)/Sub, отожженных при разных температурах. При комнатной температуре величина $MR = 1-1.2\%$, что дает возможность утверждать о наличии признаков ГМС в данном функциональном элементе. На рис. 3, *b* представлены зависимости MR для спин-клапанных структур с разной толщиной прослойки Cu. При ее толщине в 6 nm наблюдается максимальное значение MR в узком диапазоне магнитных полей. Это может быть связано с осцилляционной зависимостью MR от толщины немагнитной прослойки.

Авторы выражают искреннюю благодарность доктору наук Е. Майковой за участие в обсуждении результатов исследований.

Работа выполнена в рамках общего проекта о научно-техническом сотрудничестве между Сумским государственным университетом и Институтом физики Словацкой академии наук (Г. Братислава).

Список литературы

- [1] *Tanaka M.* // J. Crystal Growth. 2005. V. 278. P. 25–37.
- [2] *Dieny B., Speriosu V.S., Gurney B.A.* // J. Magn. Magn. Mater. 1998. V. 93. P. 101–104.
- [3] *Морозов А.И., Морохов И.А.* // ФТТ. 2008. Т. 50. В. 10. С. 1846–1852.
- [4] *Проценко С.И., Чешко И.В., Великодный Д.В. и др.* // Успехи физ. мет. 2007. Т. 8. № 4. С. 247–278.
- [5] *Pinnetier-Lecoeur M., Fermon C., de Vismes A.* // J. Magn. Magn. Mater. 2007. V. 316. P. 246–248.

Письма в ЖТФ, 2009, том 35, вып. 19